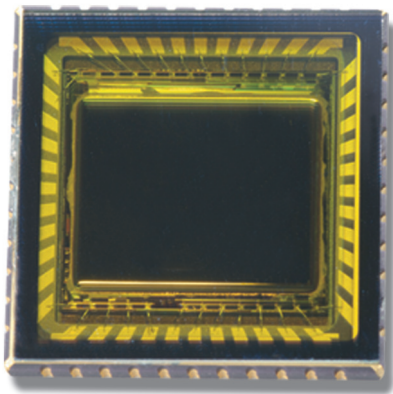


Indium-Gallium-Arsenid (InGaAs) - Matrixdetektor 320x256-C-VIS

Vorläufiges Kurzdatenblatt



Erweiterter Spektralbereich 0,5 μm - 1,7 μm

Quanteneffizienz $\geq 70\%$

Reduzierte Anzahl von Detektionskanälen für breitbandige Bildaufnahme (Image Fusion)

Ungekühlter Sensor

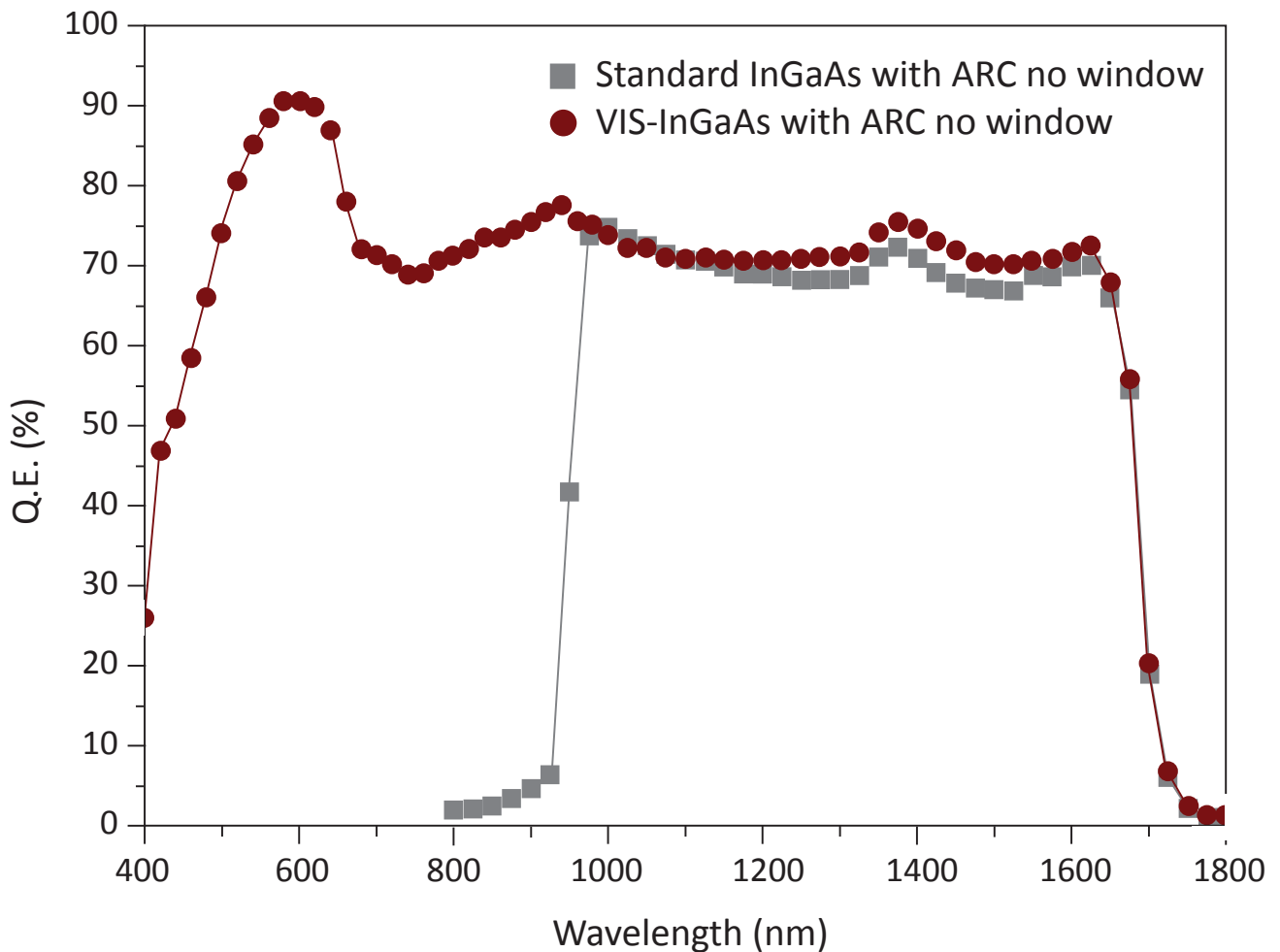
Anwendungen:

- Bildaufnahme im Nahen Infrarot
- Multi- / Hyperspektralaufnahmen
- Verdeckte Überwachung
- Halbleiter-Inspektion
- Astronomie und Forschung
- Industrielle Wärmebildaufnahme
- Bildgebende Spektroskopie
- Medizinische und Biowissenschaften
- Temperatur- und Feuchtigkeitsanalyse

Typische Werte:

Parameter	Typischer Wert	Bedingungen
Spektralbereich	0,5 - 1,7 μm	
Pixelverfügbarkeit	> 99,5 %	Dunkelstrom $\leq 20\%$ der max. Ladungsträgerkapazität und Ungleichförmigkeit der Empfindlichkeit $\leq 20\%$
Dunkelstrom	$\leq 1\text{ pA}$ $\leq 0,2\text{ pA}$	25 °C, 1 V Detektorspannung 0,1 V Detektorspannung
Quanteneffizienz	$\geq 70\%$	$\lambda = 0,5\text{ }\mu\text{m} - 1,6\text{ }\mu\text{m}$
Inhomogenität der spektralen Empfindlichkeit	< 10 %	bei 50 % Sättigung 25 °C
Nichtlinearität (maximale Abweichung)	$\leq 2\%$	im Bereich von 10 % bis 90 % der max. Ladungsträgerkapazität
Maximale Pixelrate	10 MHz	max. Taktrate 5 MHz
Füllfaktor	> 99 %	

Spektrale Quanteneffizienz:



ARC - Anti - Reflex - Beschichtung

Auflösung 320 (H) x 256 (V) Bildpunkte
 30 µm Bildpunktgröße
 Bildaufnahmefläche 9,6 mm (H) x 7,68 mm (V)
 Verstärkung
 Hoch: 13,3 µV/e- Niedrig: 0,7 µV/e-, 25 °C

Hermetisches 44-pin Keramikgehäuse (CLCC = "Ceramic Leadless Chip Carrier"), ohne Kühlung
 Gewicht 1,6 g
 Leistungsaufnahme 175 mW